

# InGaAs фотодиод 1654 нм, 300 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WIT3-300AX

## ОСОБЕННОСТИ

Высокая чувствительность  
Низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

## ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики CH4

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр                  | Обозначение | Мин. | Макс. | Ед. изм.   |
|---------------------------|-------------|------|-------|------------|
| Рабочая температура       | TSTG        | °C   | -40   | 85         |
| Температура хранения      | TC          | °C   | -40   | 85         |
| Температура (время) пайки | TL          | °C   |       | 260 / 10 с |
| Прямой ток                | Icc         | mA   |       | 10         |

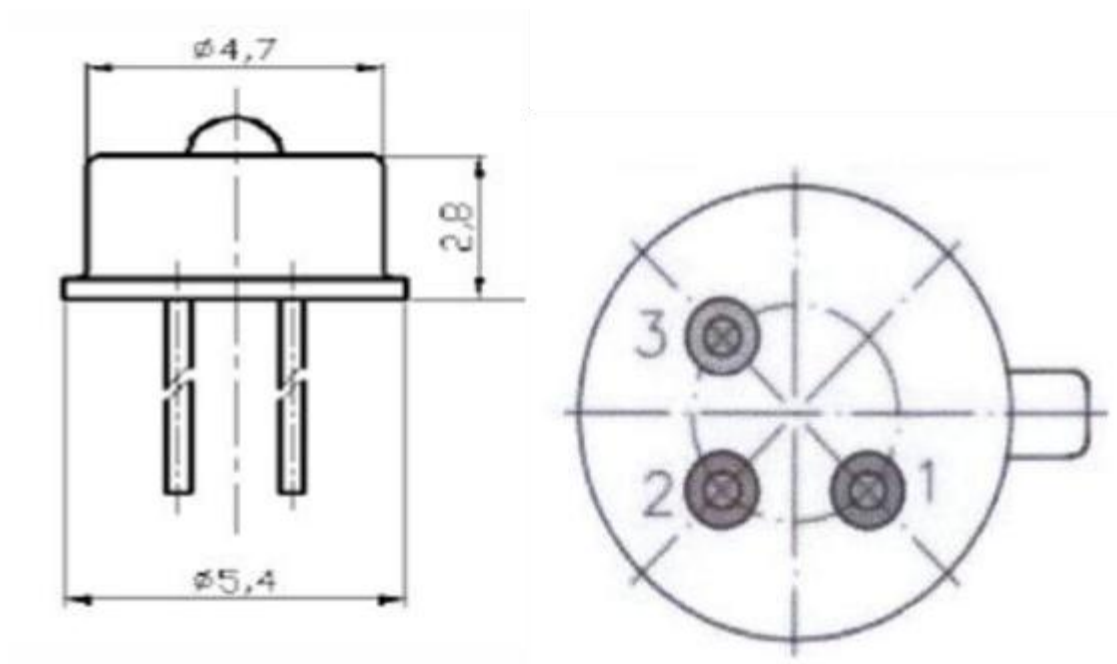
## Электрооптические характеристики (T=25 °C)

| Параметр                      | Обозначение | Условия измерения | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------|------|-------|----------|
| Активная область              | D           | -                 | 295  | 300  | 305   | мкм      |
| Темновой ток                  | ID          | VBR=-10V          | -    | 0.2  | 1     | нА       |
| Спектральная чувствительность | λ           | -                 | 900  | 1650 | 1740  | нм       |
| Чувствительность              | R           | λ=1653nm          | 0.9  | 0.95 |       | А/Вт     |
| Емкость                       | C           | VBR=-5V           |      | 7    | 10    | пФ       |

## ПРИМЕЧАНИЕ

При хранении, транспортировке и использовании рекомендуются соответствующие меры защиты от ЭСР.

## Назначение выводов и габаритный чертёж



| № вывода | Название |
|----------|----------|
| 1        | PD+      |
| 2        | PD-      |
| 3        | GND      |